

ПРОГРАММА
Школы молодых ученых
«Физика и технология квантовых систем»

27–28 ноября 2024 г.

ИФП СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева 13, конференц-зал (3 этаж)

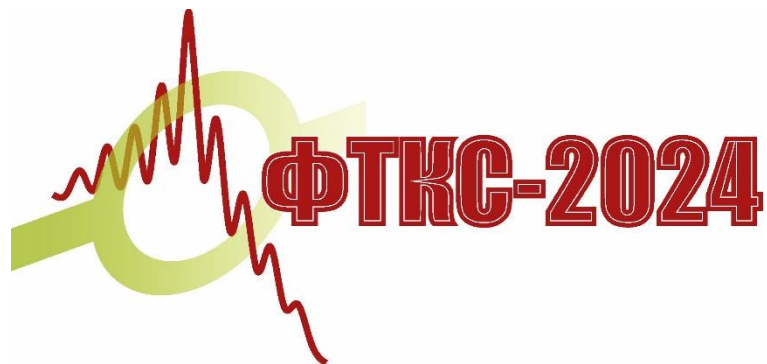
Среда, 27 ноября

8:30 – 9:00	Регистрация участников Школы		
9:00 – 9:15	Открытие. Вступительное слово – член-корр. РАН Квон Зе Дон		
9:15 – 10:00	<u>Квон Зе Дон</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Принцип Паули и трехмерные топологические изоляторы
10:00 – 10:45	<u>Волков Владимир Александрович</u>	ИРЭ РАН, г. Москва	Поверхностные и краевые состояния электронов и плазмонов в дираковских материалах
10:45 – 11:00	Перерыв, кофе-брейк		
11:00 – 11:45	<u>Бисти Вероника Евгеньевна</u>	ИФТТ РАН, г. Черноголовка	Двумерные экситоны в квантовых ямах и ван-дер-ваальсовых гетероструктурах
11:45 – 12:30	<u>Ковалев Вадим Михайлович</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Фотовольтаический эффект Холла в двумерных сверхпроводниках
12:30 – 13:15	<u>Храпай Вадим Сергеевич</u>	ИФТТ РАН, г. Черноголовка	Бывают ли электроны независимыми?

13:15 – 14:00	<u>Обед</u>
14:00 – 17:30	Представление стендов участниками Школы
	Перерыв, кофе-брейк
	Стендовая сессия

Четверг, 28 ноября			
9:00 – 9:45	<u>Быков Алексей Александрович</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Индукцированные микроволновым излучением осцилляции магнетосопротивления высокоподвижного 2D электронного газа
9:45 – 10:30	<u>Дворецкий Сергей Алексеевич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Выращивание гетеро- и наноструктур HgCdTe методом МЛЭ
10:30 – 11:15	<u>Миронов Алексей Юрьевич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Свойства наноструктурированных сверхпроводящих пленок
11:15 – 11:30	Перерыв, кофе-брейк		
11:30 – 12:15	<u>Альперович Виталий Львович</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Фотогальванические эффекты в полупроводниках
12:15 – 13:00	<u>Ненашев Алексей Владимирович</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Кубиты как наборы маятников
13:00 – 14:00	Обед		

14:00 – 14:45	<u>Курусъ Нина Николаевна</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Микро- и наноскопия низкоразмерных полупроводниковых структур
14:45 – 15:30	<u>Шкляев Александр Андреевич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Взаимодействие света с покрытиями из частиц субволнового размера при возбуждении в них резонансов Ми
15:30 – 15:40	<u>Гайслер Владимир Анатольевич</u>	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Лазеры с вертикальным резонатором для миниатюрных квантовых стандартов частоты (<i>видео-лекция</i>)
15:40 – 16:00	Вручение дипломов. Закрытие Школы		



Стендовая сессия, 27 ноября, 14:00 – 17:30, холл перед конференц-залом

№ стенда	ФИО участника	Организация	Название доклада
1	Ван Юйхань	НГУ, г. Новосибирск	Исследование механизмов формирования CaSi_2 методом послойной эпитаксии Si и CaF_2 при облучении электронами
2	Гумбарг Владислав Вячеславович	НГУ, г. Новосибирск	Рост Ge на поверхности Si(111), пассивированной Sb
3	Дураков Денис Евгеньевич	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Специфика формирования слоёв графена на поверхности 6H-SiC(0001) методом резистивного отжига в условиях СВВ
4	Залялов Тимур Маратович	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Изучение спектральных зависимостей показателя поглощения эпитаксиальных слоев GeSn и GeSiSn
5	Залялов Тимур Маратович	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Стабилизация параметров мемристорных структур на основе HfO_x воздействием электронного луча
6	Захожев Константин Евгеньевич	НГУ, г. Новосибирск	Ван-дер-ваальсовый гетероэпитаксиальный рост SnSe_2 на поверхностях $\text{Bi}_2\text{Se}_3(0001)$ и Si(111)
7	Кислухин Никита Александрович	НГТУ, г. Новосибирск	Кинетика формирования нанокластеров германия в нестехиометрических пленках GeSi_xO_y
8	Кузнецов Вадим Алексеевич	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Измерение полевой зависимости дрейфовой скорости с учётом геометрической формы образца
9	Кукенов Олжас Игоревич	ТГУ, г. Томск	Зависимость кинетики эпитаксиального роста Si на Si(100) от ширины террас
10	Курмачев Дмитрий Андреевич	НГУ, г. Новосибирск	Квазибаллистический транспорт в двумерном андерсоновском топологическом изоляторе
11	Кырова Екатерина Денисовна	НГТУ, г. Новосибирск	Исследование морфологии поверхности пленок магнитного топологического изолятора MnBi_2Te_4 на подложках Si(111)
12	Майер Ксения Александровна	ТГУ, г. Томск	Синтез удлинённых квантовых точек Ge на Si(100) методом молекулярно-лучевой эпитаксии
13	Пономарев Сергей Артемьевич	НГУ, г. Новосибирск	Фазовый переход $\beta \Leftrightarrow \beta'$ с температурным гистерезисом в пленках In_2Se_3

№ стенда	ФИО участника	Организация	Название доклада
14	Самусь Алексей Дмитриевич	СибГУ им. Решетнева, г. Красноярск	Магнитная анизотропия тонких пленок Co/MgO(100)
15	Семенкова Арина Алексеевна	СибГУ им. Решетнева, г. Красноярск	Исследование интерфейса структуры SiO _x /Si методом спектроскопии потерь энергии отраженных электронов
16	Скворцов Илья Владимирович	ИФП СО РАН, г. Новосибирск	Структурные и фотоэлектрические свойства p-i-n фотодиодов на основе гетероструктур GeSiSn/Ge
17	Соловова Надежда Юрьевна	НГУ, г. Новосибирск	Эпитаксиальный рост плёнок Na ₂ KSb
18	Хаматдинов Эльдар Ульфатович	ТГУ, г. Томск	Рамановская спектроскопия тонких пленок топологического изолятора Bi ₂ Te ₃
19	Хамуд Гайсаа Аббас	НГУ, г. Новосибирск	Фоточувствительная МДП-структура с барьером Шоттки и нанослоем германия встроенным в диэлектрическую плёнку GeSi _x O _y
20	Хорошилов Владимир Сергеевич	НГУ, г. Новосибирск	Фотоэмиссия и фотоэдс на поверхности n-GaAs с адсорбированными слоями цезия
21	Чэнь Юйчжу	НГУ, г. Новосибирск	Формирование нанокристаллов (квантовых точек) германия в плёнках GeO _x
22	Юшков Иван Дмитриевич	НГУ, г. Новосибирск	Механизм транспорта заряда в германосиликатных стёклах